

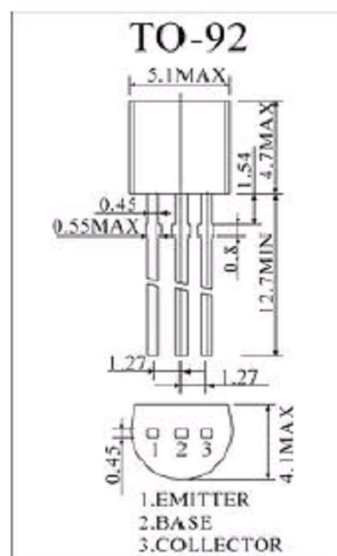
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

9018

—NPN silicon—

绝对最大额定值 (Ta=25℃)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V_{CB0}	30	V
集电极—发射极电压	V_{CE0}	15	V
发射极—基极电压	V_{EB0}	5	V
集电极电流	I_C	50	mA
集电极耗散功率	P_C	400	mW
结 温	T_j	150	℃
存储温度	T_{stg}	- 55~150	℃



电参数 (Ta=25℃)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h_{FE}	28		198		$V_{CE} = 5V, I_C = 1mA$
集电极-基极截止电流	I_{CB0}			0.05	μA	$V_{CB} = 12V, I_E = 0$
发射极-基极截止电流	I_{EB0}			0.05	μA	$V_{EB} = 3V, I_C = 0$
集电极-基极击穿电压	BV_{CB0}	30			V	$I_C = 0.1mA, I_E = 0$
集电极-发射极击穿电压	BV_{CE0}	15			V	$I_C = 1mA, I_B = 0$
发射极-基极击穿电压	BV_{EB0}	5			V	$I_E = 0.1mA, I_C = 0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	$I_C = 10mA, I_B = 1mA$
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$			1.0	V	$I_C = 10mA, I_B = 1mA$
电流增益-带宽乘积	f_T	700	1100		MHz	$I_C = 5mA, V_{CE} = 5V$
共基极输出电容	C_{ob}		1.3	1.7	PF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$

h_{FE} 分档及其标识志

D	E	F	G	H	I
28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198